

КТ3102В

Транзисторы кремниевые, эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Применяются в низкочастотных устройствах с малым уровнем шумов, переключающих, усилительных и генераторных устройствах средней и высокой частоты.

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.

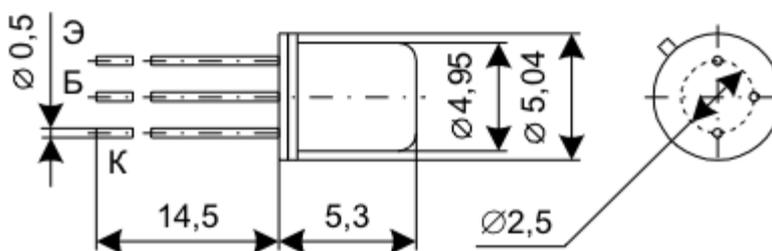
Транзисторы маркируются на боковой поверхности корпуса.

Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзисторов не более 0,5 г.

Тип корпуса: КТ-1-7.

Технические условия: аА0.336.122 ТУ.



Основные технические характеристики транзистора КТ3102В:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока для схем с ОЭ при $U_{кб}=5$ В, $I_э=2$ мА: 200...500;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока для схем с ОЭ: не менее 300 МГц;
- $K_{ш}$ - Коэффициент шума на частоте $f = 1$ кГц: не более 10 дБ;
- τ_k - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 100 пс;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб}=30$ В: не более 0,015...0,05 мкА ;
- S_k - Емкость коллекторного перехода: не более 6 пФ;
- $U_{кбо\ max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база: 30 В;
- $U_{кэо\ max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 30 В;
- $U_{эбо\ max}$ - Максимальное постоянное напряжение эмиттер-база: 5 В;
- $I_{к(и)\ max}$ - Максимально допустимый постоянный (импульсный) ток коллектора: 100(200) мА;
- $P_{к\ max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 250 мВт;
- $t_{окр}$ – Температура окружающей среды: -40...+85°C.

Допускается использование транзисторов в инверсном включении.